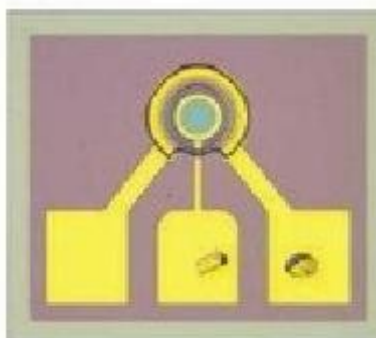


850-910nm 56Gbaud PD Chip $\phi 32\mu\text{m}$



产品描述

850nm GaAs PIN 高速光探测器芯片

产品特点

数据速率高达 100Gbps/channel; 响应范围: 850nm-910nm; 850nm 高响应度; GSG 电极结构

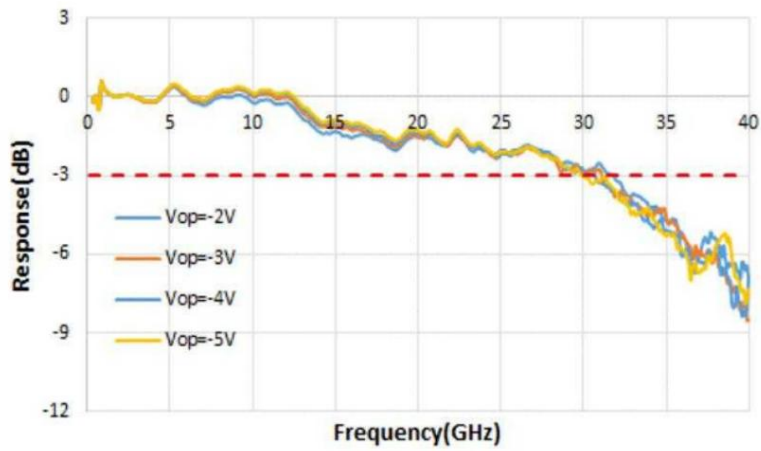
应用领域

100/400/800Gbps WDM PAM4 | 200Gbps QSFP56 SR4/FR4 | 4×56Gbps 光纤通道

核心参数

无
无

详细参数



规格 (Tc=25°C, 单颗裸芯片)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
响应范围	λ		850	910	nm	
响应度	R	0.55	0.6		A/W	$\lambda=850\text{nm}$
暗电流	I_D		0.01	0.05	nA	$V_R=-5\text{V}$
电容	C		0.05	0.08	pF	$V_R=-2\text{V}, f=1\text{MHz}$
带宽	Bw		32		GHz	$V_R=-2\text{V}$ 3dB down, RL=50 Ω
有效区直径	D		32		μm	
通道之间的中心 间距(pitch)			250		μm	